

# 半导体学报

第 10 卷 第 3 期 1989 年 3 月

## 目 录

- ZrN/*n*-GaAs 肖特基势垒特性研究····· 张利春 高玉芝 N.W.Cheung (161)  
器件模型参数优化提取的混合算法····· 郝 跃 贾新章 (168)  
InGaAsP/InP 准平面异质结双极晶体管及其与光器件的集成·····  
·····李维旦 富小妹 潘慧珍 (173)  
MoSi<sub>2</sub> 硅化物的形成及电子结构的研究·····  
·····李宝骐 季明荣 吴建新 许振嘉 阎 江 (179)  
Au、Al/*a*-Si:H 热退火行为研究·····  
·····金 澍 刘洪图 赵特秀 吴志强 沈 波 许振嘉 (186)  
亚微米栅长调制掺杂场效应管 (MODFET) 的制造·····  
·····杨玉芬 陈宗圭 张 矩 (192)  
用 RC 网络作延迟模型的开关级定时模拟·····胡 易 王兆明 (198)  
钨硅化物砷化镓 Schottky 接触的形成和特性·····  
·····祝忠德 许 虹 宁宝俊 李晓光 (207)

## 研 究 简 报

- 退火对 Ar<sup>+</sup> 激光再结晶多晶硅/二氧化硅界面性质的影响·····  
·····陈 坚 黄信凡 鲍希茂 (217)  
MBE 高掺 Be *p*-GaAs 中  $E_g + \Delta_0$  等高于带边的发光·····  
·····胡天斗 许继宗 梁基本 庄蔚华 (222)  
漏轻掺杂 MOSFET 的源漏穿通·····谢连生 陈学良 徐元森 (227)  
As<sup>+</sup>、Si<sup>+</sup> 双注入 GaAs 瞬态退火的行为·····范伟栋 王渭源 (230)  
衬底对 *a*-Si:H 激光结晶的影响·····鲍希茂 顾 清 黄信凡 (233)  
紫外光/臭氧干法去除光刻胶·····谈凯声 祁宜芝 (236)

2801